Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-089219

(43) Date of publication of application: 15.04.1991

(51)Int.Cl.

1/35 GO2F

(21)Application number: 01-226515

(71)Applicant: TOYOBO CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: NAKAMURA SATOSHI

IMAHASHI SATOSHI

(54) NONLINEAR OPTICAL MATERIAL

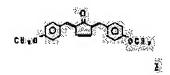
(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the nonlinear optical sensitivity of the above material and to enhance the preservation stability and laser resistance by using a specific dibenzyl ketone derivative.

31.08.1989

CONSTITUTION: The dibenzyl ketone deriv. expressed by formula I is used as the above material. In the formula, A, B denote a (substd.) arom. hydrocarbon group; x denotes 0, 1; y denotes 0 to 4. The resonance effect by the interaction of charge transfer phases is increased when an electron donative group is introduced into the ortho position or para position of the groups A, B. The compounds expressed by formula II, etc., are usable. This material is obtd. by bringing the corresponding acetone or cycloalkanone and substd. benzaldehyde deriv. into dehydration condensation reaction in the presence of a catalyst.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP) ⑪ 特 許 出 願 公 開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-89219

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号 7348-2H

@公開 平成3年(1991)4月15日

G 02 F 1/35

504

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

50発明の名称 非線形光学材料

> ②特 顧 平1-226515

願 平1(1989)8月31日 22出

70発 明 者

滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋防續株式会社総合

研究所内

明者

滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋防續株式会社総合

研究所内

の出 願 人 東洋紡績株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

1. 発明の名称

非線形光学材料

2. 特許請求の範囲

1. 下記一般式(1)で表されるジベンザルケ トン誘導体を含むことを特徴とする非線形光学材 Ħ

(式中、x は 0 又は 1 であり、y は 0 ~ 4 の整 飲である。A、Bは置換基を有するか、又は有し ない芳香族炭化水素基であり、同一であっても異 なっても良い。)

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光情報、光通信等に用いられる非線形 光学材料に関するものであり、更に詳しくはジベ ンザルケトン誘導体からなる有機非線光学材料に

関する。例えば半導体レーザー用波長変換素子、 光空間変調器等の光関連機器に用いることができ

(従来の技術)

レーザー光は単色性、指向性、コヒーレント性 を有するため物質に特異的な相互作用を及ぼす。 この相互作用は非線形光学効果として知られてお り、高調放発生、カー効果、光混合、パラメト リック増幅等の現象を起こす。特に二次及び三次 非線形光学効果は比較的大きな非線形態受率が期 **待できるため情報処理、光週信等への応用が可能**

従来、非線形光学材料としてKDP(KHaPOa) 、AD P(NBaBaPOa)LinbOa 等の無機材料が使用され、一 部の測定機器に応用されてきた。しかし純度の高 い単結晶が得にくく、又高価であること、耐光措: 保性に劣ること、選解性であること、非線形光学 感受率が小さいこと等の理由から光関連への応用 は困難であった。

近年になって、無機材料に比べ有機材料が優れ

特開平3-89219(2)

た非維那光学効果を有することが見出だされて以来、分子設計の点で自由度の高い有機材料が注目を浴びている。

特に、2-メチルー4-ニトローアニリンに代表されるような x 電子が共役し、分子内に電子供与性置換基及び電子吸引性置換基を有した C - T (Charge-Transfer)型有機化合物が大きな分子超分極率を誘起するため大きな非線形態受率が期待できると考えられてきた。

しかし、有機化合物の結晶構造は分子で開めて 特別の方子では、する。上記の名の を表情によって決定では子供与性を 強いを子吸引性を検索を子供の分子である。 とこって型分子の場合、分子ではなる では、分子ではなるでは、分子ではなるでは、 な子のでは、お品を安定させる機造を子のでは、 な子のでは、お品を安定させる機造をといる。 のでは、ないでは、 のでは、 のでは

そこで、このような結晶構造の中心対称性を崩

- 壊させる手段として次のような手法が用いられて
 - ① 水素結合性の寄与が大きい置換基の導入
 - ② 立体的な障害によって分子のねじれを誘起 させるパルキーな置換基の導入
 - ③ 光学活性な置換基の導入
 - ④ 包接化合物との錯体
 - (5) 再結晶有機溶媒(スローエパポレーション 法等)

これらの手法を考慮に入れて合成された代表的な化合物がRNA やNPP (n-(p-ニトロフェニル) プロリノール) であり、かなり大きな二次非線形感受率を呈する事が知られているが、まだ十分でない。

- 一般に二次非線形光学材料が非線形光学素子として適用できる必要十分な条件として以下の点が挙げられる。
 - ① 非線形光学感受率が極めて大きい
 - ② 光応答速度が早い
 - ③ レーザー光の透過性に優れている

- ② 耐光损傷性
- (5) 位相整合性
- ◎ 結晶性(単結晶育成の可能性等)
- ① 器械的强度
- ⑱ 加工が容易である
- ② 耐湿性など化学的に安定である
- 00 世界華性

(発明が解決しようとする課題)

超分極率が大きく、中心対称性のないHNA や RPPのようなC-T型分子及び s 電子共役の長い分子の場合、大きな二次非額形態受率は期待できるが、実用に供することができる程の感受率を与えていない事等の欠点を有している。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは上記課題である大きな非線形光学 郡受率を有する優れた有機化合物を得るため、 観 倉研究努力した結果、遂に本発明を完成する に 到った。すなわち本発明は下記一般式 (I) で示されるジベンザルケトン誘導体を含むことを特徴とずる非線形光学材料である。

(式中、x は 0 又は 1 であり、y は 0 ~ 4 の整数である。 A、 B は置換基を有するか、又は有しない芳香族炭化水素基であり、同一であっても異なってもよい。)

本発明のジベンザルケケスのでは、、は分極を大きくいのでは、、なりのでは、、なりのでは、、方ののでは、、方ののでは、、方ののでは、、方ののでは、、方ののでは、、方ののでは、、方のでは、、ののでは、、、ののでは、、、ののでは、、、ののでは、、、ののでは、、ののでは、、、ののでは、、、ののでは、、、ののでは、ののでは、

本発明において芳香族炭化水素基A、Bとして 具体的にはベンゼン酸、ナフタレン酸、アントラ

特開平3-89219(3)

セン環、ピフェニル環、ターフェニル環、ピナフチル環、チアゾール環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、ピリジン環、ピリミジン環、ピラジン環、ピリダジン環、トリアジン環、テトラジン環等を挙げることができる。

なお本発明においては芳香族炭化水素基 A 、 B は少なくとも一方に電子供与性基を有しているこ とが好ましい。

電子供与性基とは、 Bannett の 置換基定数 σ で で σ く 0 を 満 た す 置換基で あ り 、 ア ミ ノ 、 モ ノ メ チ ル ア ミ ノ 、 ジ メ チ ル ア ミ ノ 、 ジ メ チ ル ア ミ ノ 、 ロ ー ブ チ ル ア ミ ノ 、 ロ ー ブ チ ル ア ミ ノ 、 ビ ロ リ ジ フ 、 ビ ロ リ ジ で あ な ノ ル マ ル ア ル ト キ ル 基 、 は ー チ オ ブ ト キ ル 基 、 は ー チ オ ブ ト キ シ 基 の ほ な た ロ キ シ 基 、 よ ル カ ブ ト 基 及 び ハ ロ ゲ ン 等 を 用 い る こ と が で き る 。

さらに電子吸引性 置換基とは、σ>0 であるニトロ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、イソシアネート基、スルフォニル基、ホルミル基、カルボキシル基、炭素数 1 ~10 であるアルキル 額を有するアルコキシカルボニル基、 τ ーブトキシカルボニル基、アセチルアミノ 基及びハロゲン等を用いることができる。

本発明の有機非線形光学材料の製造方法として、 種々の合成方法が考えられるが下式に従うクライ ゼンーシュミット縮合股水反応を利用して好通に 合成できる。

$$(CH_{z})_{y} + \bigotimes_{R_{1} \sim z} z - CH_{0} \rightarrow \bigotimes_{R_{1} \sim z} z \bigotimes_{R_{1} \sim z} z$$

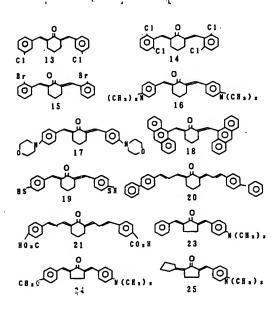
即ち、対応するアセトン又はシクロアルカノンと置換ベンズアルデヒド誘導体とを塩基性触媒または酸性触媒下で脱水縮合反応を行うことにより得ることができる。

塩基性触媒としては水酸化ナトリウム、水酸化

カリウム、ナトリウムアルコキシド、種々のアミン類、種々の四級アンモニウム塩を用いる事ができ、酸性触媒としては塩酸、硫酸、酢酸、三フッ化ホウ素酸、三フッ化ホウ素エーテラート等を用いる事ができる。

本発明において用いられるジベンザルケトン誘導体としては、例えば、下記構造式で示される化合物を挙げることができる。

特開平3-89219 (4)



(作用)

本発明で用いられる化合物は、大きく広がった x 電子共役型構造を有し、又程よい双極子モメントを持つジベンザルケトン誘導体であり、分子 求確に分子内共鳴をおこし、さらにベルク構造を 変化させることの出来る分子配向制御基を導入する ることによって、非中心対称性構造を実現させう る分子構造であるため、極めて大きな非線形感受 率を与えるものと思われる。

(実施例)

以下、実施例にしたがって本発明を更に詳しく 説明するが、本発明はこれら実施例に限定される ものではない。

なお第二次高調放発生 (SBG) の測定は 郭 1 図 に示す第二次高調放発生装置を用い、粉末法 (S 、 E 、Kurz、T 、T 、Perry 、39、3798(1968)) に 従って行った。 別定に用いた光源はNd:YAGレーザーであり、 基本被長1064nmのレーザー光を粉末は料へ照射し、発生する二倍波(532nm)を分光器で検出した。 また、 使用した粉末は料は反応から分取した結晶、アセトン、酢酸エチル、トルエンで再結晶精製したものをそのまま用いた。

家族 例 1

温度計を設置した300 転反応容器にエタノール150 転及び霧留水15 転に溶解させたNa082.38 g (59.5aH)を仕込み、シクロベンタノン5.0 g (59.5aH)を加え5でに冷却して微神しておく。10分間微神した後、pーメトキシベンズアルデヒド16.2 g (119.0aH)を被牛に滴下した。 1時間後、折出した沈殿物を被圧下濾過分取した。 1時間後、折出した沈殿物を被圧下濾過分取した。 沈殿物は霧留水50 転で5 回洗浄しさらにエタノール50 転で5 回洗浄した後、被圧加熱乾燥を行い11.0 g の前記化合物 № 1 の租生成物を得た(92%)。この生成物はアセトン、酢酸エチル、トルエンを用いて再結晶を行い、生成物の確認は8'-NHR、「Rで行った。

特開平3-89219(5)

H'-MMR(CDCI:) ,... :3.06(4H.S) . 3.84(6H . S) . 6.95(4H . a . J - 9) . 7.53(2H . S) . 7.55
(4H . d . J - 9)

[R(KBr)cm ':3100 ~2800, 1710, 1615, 1520, 1270, 1190, 1050, 860

上記方法により前記試料のSHG 強度を測定した ところ、尿素に対して55.5倍(アセトン)、50.5 (酢酸エチル)、25.0(トルエン)のSHG 活性を 確認することができた。

実施例 2

温度計を設置した二口反応容器にエタノール75 試及び慕留水 8 域に海解させたNaOB1.2 gの水溶 液を仕込んだ。これへシクロベンタノン2.5 g (29.8mM)を加え、約5℃に冷却した後、オルト クロロベンズアルデヒド8.4 g(59.5mM)を被除っ に満下した。30分間獲搾した後、折出したは殴物 を減圧下分取し、源留水50域で5団洗浄的した後して、 タノール50域で3回洗浄し、減圧下加熱的 タノール50域で3回洗浄し、減圧下加熱的 が開発性にない、減圧下加熱的 の租生成物8.5 g(92%)を得た。 得られた結晶はアセトン、トルエンで再結晶特製 した.

この化合物のH'-MMR及びIRデータを以下に示す。
H'-MMR(CDC(:) ,, : ; 2.99(4H 、 S)、7.22~7.

36(5H 、:)、7.42~7.58(3H 、:)、7.93(2H 、 S)
IR(KBr)c= -';3100 ~ 2800、1710、1625、1525、
1270、1190、1050、850

実施例 1 と同様の方法により SRG 強度の測定を行ったところ、アセトンで再結晶した結晶は SRG 不活性であったがトルエンで再結晶した試料は尿素に対して46.0倍の SRG 活性を確認した。

実施例3

世及び落留水 8 世に海解させた Na OB 1.2 g の水溶 実施例 1 と同様の反応で、エタノール150 吐、液を仕込んだ。これへシクロベンタノン2.5 g Na OB 1.2 g / H = O10 吐、シクロベンタノン2.5 g (29.8 m M) を加え、約5℃に冷却した後、オルト (29.8 m M)、p ートルアルデヒド7.14 g (59.6 m クロロベンズアルデヒド8.4 g (59.5 m M) を徐々 ー M) を用い、約記化合物 Na 3 の租生成物 8.0 g にまて、4、20分間 原始した後、折出した対図物 (93%)を得た。

SRG 測定用試料として、反応からの沈殿物、酢酸エチルによる再結晶精製物を調整した。

実施例 1 と同様の方法により SRG 強度の測定を 行ったところ、酢酸エチルによる再結晶精製物は

不活性であったが、反応からの沈澱物は尿素に対 して54.0倍のSHG 活性を示した。

爽 施 例 4

次に得られたモノベンザルケトン誘導体415 ms (1.7078mM)、ベンズアルデヒド180 ms (1.7mM)、NaOH272 ms (6.8mM) を50 mt 反応容器へ仕込み、反応将媒として2ープタノール5.1 mt を用いて反応を行った。3時間加熱選流した後、氷水にあけクロロホルムで3回抽出し、無水硫酸マグ

ネシウムで乾燥した。溶媒を被圧下除去した後、 前配化合物 No. 23 の粗結晶 230 . 55 g (97%) を得た。 得られた化合物の B'-NHR. IR データを以下に示す。

H'-NMR(CDCI::1.15(6H, t), 3.0(4H, brs), 3.35(4H, q), 6.65(2H, d), 7.1 ~7.6(9H, m)

IR(KBr)cm - ':3000 ~ 2800, 1690, 1620, 1590, 1530, 1190, 820, 770, 700

実施例5

H'-HMR(CDCI:):1.18(68 , t), 3.0(48, brs), 3.15~3.60(48 , q), 3.8(38, s), 6.5 ~7.0(48,

特閒平3-89219(6)

m) , 7.25~7.60(6H , m)

IP(KBr)cm -1;3000 ~ 2800 . 1680 . 1600 . 1580 . 1250 . 1180

実施例6~22

実施例 1 および実施例 4 と同様に反応して得られた化合物の尿器に対するSHG 強度比を実施例 1 ~ 6 とともに第 1 衷に示す。

但しSBG 強度比は、各粗生成物の得られる状態で異なるので、それぞれの最高値で示した。

第 1 表

実	施	例	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
化	÷	Wh	1	2	3	23	24	4	5	7	11	13
SHC	独	皮	55.5	46.0	54.0	54.3	60.3	40.0	12.0	5.0	41.0	8.0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	15	16	25	27	28	29	32	34	35	37	38 .
3.0	5.5	102.0	44.2	12.2	30.4	48.3	12.5	11.1	30.3	11.9	40.3

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例において使用した 第二次高調波発生装置を示す機略図である。

第2図、第3図、第4図は化合物 Ma 1~3の赤 外吸収スペクトルである。

1 ; Q スイッチNd;YAG レーザー

2:1064am用レーザーミラー

3: シャッター

4: 試料

5;築光レンズ

6:赤外カットフィルター

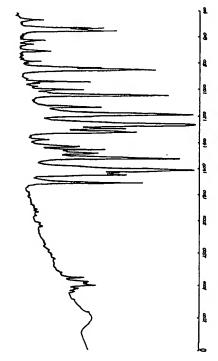
7:ポリクロメーター

8:マルチチァンネルフォトダイオード(MCPD)

9 : MCPD駆動回路

10: コンピューター、インターフェース

特許出願人 東洋紡績株式会社



國

